(19) 日本国特許庁(JP)

(11)特許出廢公開番号 (z)公開特許公報 (A) 特開平11-9778

4

19)4A9B

				(43)公開日	(43)公開日 平成11年(1999
(51) Int. C1.		\$ 別配身	FI		
H01S 3	3/133		H01S 3/133	3/133	

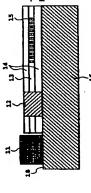
	審査請求 未請求 請求項の数7	70		(全12頁)	
(21) 出版集号	特置平9-255122		71)出版人	(71)出題人 000004226	
				日本電信電話株式会社	
(22) 出版日	平成9年(1997)9月19日			東京都新宿区西新宿三丁目19年2号	
			(72) 発明者	田中 烙名	
		_		東京都新宿区西新宿三丁目19番2号	H H
				包佰包括株式会社内	
			(72) 発明者	左 经	
				東京都新宿区西新宿三丁目19番2号	H
				组信電話株式会社內	
			(72) 発明者	金子 明正	
				東京都新宿区西新宿三丁目19番2号	H
				电信包括 株式会社内	
			(74)代型人	弁理士 谷 戲一 (外1名)	
				最終 頁に概。	まり

(54) 【発明の名称】周波数安定化レーザ

(57) [要約]

【映題】 過度変化に起因するモードホップを抑圧して フーチの影顔四弦数を安定化する。

開折率恒度係数と逆符号の屈折率温度係数を有する材料 因彼数安定化レーサである。半導体レーザダイオードの が、半導体レーザダイオードと光鉄起グレーティングの 間の光導波路の上部クラッドとコアを除去した部分また 【解決手段】 同一の基板上に搭載された半導体レーザ ダイオードと光導放路とを有し、光導故路に光誘起グレ **ーティングが形成されている集積型外部共仮器を用いた** は上部クラッドとコアと下部クラッドを除去した部分に 布積かれたころ。



[特許請求の億囲]

部共板器を用いた周被数安定化レーザにおいて、前記半 **導体レーザダイオードの屈折率温度係数と逆符号の屈折** と下部クラッドを除去した部分に搭載されていることを **ードと、前記基板上に作製された光導波路と、販光導波** ラッドとコアを除去した部分または上部クラッドとコア 【謝水項1】 基板上に搭載された半導体レーザダイオ 路に形成された光鱗超グレーティングからなる集積型外 **専温度係数を有する材料が、前配半導体レーザダイオー** ドと前記光誘起グレーティングの間の光導被路の上部ク 特徴とする周波数安定化レーザ。

おいて、前配光導波路が石英系ガラスで構成されたこと 【髆水項2】 請水項1に記載の固波数安定化レーザに を特徴とする周波数安定化レーザ。 請水項1または2に記載の周波数安定化 レーザにおいて、前記上部クラッドとコアを除去した部 分または上部クラッドとコアと下部クラッドを除去した 部分が導放路を80~90度の角度で横切っていること を特徴とする困波数安定化レーザ。 【糖水項3】

【精水項4】 精水項2に配載の周故数安定化レーザに 上部クラッドとコアと下部クラッドを除去した部分が導 おいて、前記上部クラッドとコアを除去した部分または 被路を80~87度の角度で機切っていることを特徴と する困波数安定化ワーボ。

ຂ

ドを除去した部分が複数本の構から構成されることを特 【請求項5】 請求項2から4のいずれか1項に記載の 周故数安定化レーザにおいて、前配上部クラッドとコア を除去した部分または上部クラッドとコアと下部クラッ 徴とする周波数安定化レーザ。

【請求項6】 請求項5に記載の周波数安定化レーザに おいて、前配複数本の溝を連結する溝を有し、前配連結 用の構に液だめが連結されていることを特徴とする周波 数安配化フード。

【請求項7】 請求項2から6のいずれか1項に配載の 周波数安定化ワーガにおいて、前記半導体ワーザダイオ 一ドの屈折率個度係数と逆符号の屈折率温度係数を有す K)以上であることを特徴とする国波数安定化ワーチ。 る材料の屈折母温度係数の絶対値が1×10~4(1/ 発明の詳細な説明】

[発明の属する技術分野] 本発明は、光導被路中の光誘 た、キードホップが抑制された周波数安定化ワーザの構 構成される外部共仮器型の周波数安定化レーザにおい 起グレーティングと半導体LD(レーザダイオード) 造に関するものである。 0001

【従来の技術】石英系導成路中の光誘起グレーティング と半蹲体LDで構成されるレーがは、グレーティングの

8

特開平11-97784

周放数選択性を利用して単一キード発援をする、温度係 数が半導体レーザに比較して小さい、 発板周波数の制御 が容易である等の特徴を有するため、光通信、光惊報処 理、光計劑、分光用光顔として様々な応用が期待されて 0.13, 1202, (1996)および田中他 1.9.9 7年紀子侍報通 光誘起グレーティングの作製技術については、ケニース ・オー・ヒル等により発明されている(特開平7-14 信学会総合大会購饭醯文集、C-3-160)。 なお、 いる(T. Tanaka, et al., Electron. Lett., vol.32,

0311号公報)。以後、光誘超グレーティングを名称

2

の簡略化のためグレーティングと言い換える。

【0003】図13は従来の技術を用いて作製した周波 Dであり、13は石英導液路のコアであり、14は石英 数安定化レーザの模式的斜視図である。11は半導体し り、16はS:基板であり、18は半導体L口を格斂す るために石英ガラスを取り除いた部分でシリコンテラス 導波路のクラッドである。15はグレーティングであ と呼ばれている。

しロで構成される函数数安定化レーザの発版モードを以 下に説明する。半導体1.Dに注入電流を流し発光させる と、グレーティングの反射スペクトルに対応した周波数 の光のみがグレーティングで反射される。従って、半苺 び半導体LDの後端面以外からの半導体LDへの反射戻 り光が無いように、半導体LDの出力面には空気との界 面に対する反射防止膜が施され、石英導被略のLD側の 般にグレーティングの反射周波数の帯域は50GH2程 であるので縦モードの周波数間隔は20GH z程度とな り、縦モードが3本程度存在し得る。従って、この中で グレーティングの反射中心周波数に最も近いものだけが **選択されて発振する。なお、一般にグレーティングの反** 【0004】石英系導放路中のグレーティングと半導体 体LDの後猶固かのグァーティングまやの区間をワーザ キャピティとして発板する。なお、グレーティングおよ 協画はコアの近傍部がコアの光軸に直交する方向に対し 度である。一方、レーザキャピティ長が0. 5cm程度 射率は40~99%、半導体LDと石英系導放路との光 て傾いている (特開平5-15523号公報参照)。 の結合損失は4dB±1.5dB程度になっている。

下にその理由を説明する。従来の周波数安定化レーザの 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 周波数安定化レーザでは、選択される縦モードの周波数 が温度に依存するので、温度変化と共に発板するモード が変わる現象を生じる(以後モードホップと呼ぶ)。以 催モードの温度係数は、近似的に式(1)に示される。 [0005]

\$

[9000] (教1)

 Ξ

3

$$m = \frac{m_{LD}n_{LD} + m_{wa}n_{wo}L_{wo}}{n_{LD}L_{LD} + n_{wo}L_{wo}}$$

周波数の恒度係数mwiの大きさよりも大きい。 温度係数mwaに等しい。min = 10mwaなので、鉄モー れており、反射中心周被数の温度係数は、石英導液路の 長を扱す。 グレーティングは、石英導波路中に存き込ま ロの田代稿やのグァーアィングの中心またの石炭砕液路 折邸および石英導波路の尊価屈折率である。 し…および rivおよび u waは、それぞれ半導体しDの導波層の等価屈 路と存製した共成路の共版四複数の質質条数とある。n Lwalt、それぞれ半導体LDの共扱器及および半導体L 体LDの共版器の共版因被数の温度係数および石英導液 ドの温度保敷mの大きさは、グレーディングの反射中心 【0007】ただし、mustic以mwaは、それぞれ半導 5

イングの反射中心周波数の温度保数は貸しへない。 【0008】すなわち、縦モードの温度係数とグレーテ

プが芍圧された固複数安気のフーチを境余することにも 一致させることにより、温度変化に起因するモードホッ グの反射中心周波数の温度保数と誤ネードの温度保数を になされたものであり、本発明の目的は、グレーティン 母を上昇させるため、抑制方法の実現が留まれていた。 ホップが生じていた。モードホップは伝送信号の誤り陥 02, (1996) の例では温度変化により5℃おきにモード anaka, et. al., Electronn.Lett., vol.32, no.13, 12 がN+1毎目に移り、モードホップが生じる。文献T. T ログフーティングの反対中心国被数に吸む近い禁ホード **毎目の縦モードで発板していたとすると、温度変化によ** 【0010】本発明はこのような問題点を解決するため 【0009】図14にホードホップの競用図を示す。N မ 20

¥.

[0011]

た部分に搭載されていることを特徴とする。 部分または上部クラッドとコアと下部クラッドを除去し 囲折母組度保敷と逆符号の屈折母温度保敷を有する材料 安成化フーガにおいて、 何記半導体フーガダイギーでの 製された光導波略と、腹光導波路に形成された光路超グ イングの間の光導故路の上部クラッドとコアを除去した が、控罚半段存フーシダイギードで控罚光原因グフード **裕良された半導体フーサダイギードで、四門協校上に合 ために、本路里による国際教教伝介フーガは、超校士に** フーティングからなる独積型外部共被器を用いた固波数 【原題を解決するための手段】上述した目的を遊成する

ましくは80~87度の角度に査空している。 た部分または上部クラッドとコアと下部クラッドを除去 ガラスで構成される。前記上部クラッドとコアを除去し した部分が苺波路を好ましくは80~90度、さらに好 【0012】ここで、好ましくは前記光導液路が石英系

コアを除去した部分または上部クラッドとコアと下部ク 【0013】さらに、好ましくは、前記上部クラッドと 8

> だめが連結されていることも好ましいことである。 記複数本の排を連結する誰を有し、前記連結用の誰に液 ラッドを除去した部分が複数本の犇から構成される。前

上である。 型の屈だ母道展保教の語は信が1×10-4(1/K) の屈折率温度係数と逆符号の屈折率温度係数を有する材 【0014】好虫しへは、前記半導体レーサダイオード

分に搭載されている。 または上部クラッドとコアと下部クラッドを除去した部 た光銹起グワーティングを備え、半導体ワーザダイギー グの間の光導被略の上部クラッドとコアを除去した部分 材料が、半導体フー护ダイギー ドて光霧結グフーアィン ドの屈折率温度係数と逆符号の屈折率温度係数を有する は、基板上に搭載された半導体レーザダイオードと、同 【発明の実施の形態】本発明による周波数安定化レーギ

ることにより、禁モードの温度係数をグレーティングの 母温度係数と逆の材料を温度係数調整材料と記載する。 係数と逆の材料を搭載する領域の大きさを適切に設計す 存り口の配言符合することは、国政教状気のフーシのフ る。従って、屈折率温度係数が半導体LDの屈折率温度 光路長変化を打ち消すことができ、その結果レーザキャ ーガキャプアム中において温度仮允による半導体し口の Dの屈折卓温度保敷と逆の材料をグレーティングと半導 反射中心周波数の温度係数に一致させることができる。 ピティの共級周波数の温度係数を小さくすることができ プを抑制できる。すなわち、屈折率温度係数が半導体1 [0018] 【0017】以後、屈折率温度保敷が半導体しDの屈折 【0016】本発明の上述した構成によってモードホッ

【寒焔例】以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細

返しの説明は省略する。 て、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り 【0019】なお、実施例を説明するための全図におい

6 系ガラスで構成された周波数安定化レーザを例に挙げて 【0020】 (実施例1) 実施例1は、光導波路が石英

3は石英苺被路のコア、14は石英導被路のクラッド、 直角方向に設けた鎌中に搭破した温度係数調整材料、1 上面図である。11は半導体LD、12は石英導被路と **や。図1は、フーガの財価図れあり、図2は、フーガの** 15はグレーティング、16は5 i 基板、18はシリコ 【0021】図1、図2に本発明の第1の実施例を示

【0022】半導体LDの液長は1.55μmである。

度係数mは近似的に式(3)で表される。 図1、図2に示した周波数安定化レーザの紙モードの温 v = 193 (THz)* [0023] **% [0024]** 【数2】

2

沿って国被教安に介フーザのおおよその光の周波教は式

3

特開平11-97784

m = mtontoLto+mwonwoLwo+ma na La niblio+nwalwa+nm Lm (3)

価阻抗率、温度係数國際材料の阻抗率である。 Lun、 L 係数調整材料の共振周波数の温度係数である。ncp、n 部分を共振器とした場合の共級周波数の温度係数、温度 導体し口の共振器の共振周波数の温度係数、石英導波路 **調慰材料が搭載された部分の乗さ、半導体に口の出射編束** 母、半導体LDとグレーティングの間の石英導液路の等 wc、 u " は、それぞれ半導体し口の導液層の等価屈折 【0025】ただし、mi.io、mwo、mmは、それぞれ半 Lwalt、それぞれ半導体LDの共振器長、温度係数 5

[0026]

★からグワーティング中心またの石炭環液路部分の果さ 式 (4) で得られる。 なわち石英導液路の温度係数manの笠で割ることにより モードホップの温度間隔では、紙モードの周波数回隔を 縦モードの恒度保敷mとグレーティングの恒度保敷、す (温度係数調整材料が封入された領域を除く)を表す。

2 (nipLip+nwalwa+nm Lm) mwe-m

⊢]

×10" (m/s) いある。 【0027】ただし、cは光の遊さを表し、c=3.0 なていない領域も環度保吸の頃は同じてある。

作製した共協器の共協周波数の温度保敷は、光弾性効果

【0029】一揆に、屈が母n、模筋破免数 a の女学で

を無視すると式(5)で嵌されることが知られている。

[0030]

封入された領域を除く石英導被路部分の共福周波数の温 度係数m***の具体的な数値を得るための計算を記す。 :: **いた、グレーティングが形成されている領域も形成されな** 【0028】本実施例1において、温度保敷調整材料が

[数5]

6

 $\frac{d\nu}{dT} = -\nu \left(\frac{1}{n} \frac{dn}{dT} + \alpha \right)$

で式 (6) で表される。 【0031】 屈折率の温度係数は、材料は石英であるの **\$**30 **♦**[0032] [8 後]

$$\frac{dn}{dT} = 7. 0 \times 10^{-4} (1/K)$$

6)

1のレーザでは、コア13、クラッド14の石英部分の 【0033】石灰導液路部分の線膨張係数を状める。図 * 導液路部分の凝磨張係数 a waはS i 基板の凝磨張係数で 安される (式 (7))。

板16の厚みは1mm程度と十分大きい。 従って、石英* 厚みが合わせて60μm程度であるのに対して、Si基 [0034]

 $\alpha = \alpha_{w_1} = 2.33 \times 10^{-4} (1/K)$

3

=n**;=1.45粉よび、式(2)、式(6)、式 液路部分の温度係数mwalt、石灰導液路の等価屈折率n 40 【0035】 従った、半導体ID編からグワーティングまたの石英導 (7) を式(5) へ代入することで、式(8) で得られ※ ×.

 $m_{\nu 0} = \frac{d\nu}{dT} = -1.4 (GHz/K)$

8

【0036】 同様の計算手順で温度調整材料の温度係数 【0037】温度係数闘整材料には、シリコーン樹脂を ★屈折率の温度係数は、式(9)で表される。 [0038]

用いている。シリコーン按照の屈抗母n...は1.39、* $\frac{dn}{dT} = -3. 9 \times 10^{-1} (1/K)$

3

板の戽み1mmに比較して小さい。群の作取力法につい* ラッドとコアまたは上部クラッドとコアと下部クラッド を除去することで作製した欲さ30gm~60gmの街 中に対入されており、祖度係数調整材料の厚みはSi基 [0039] 温度係数間整材料は、石英導故路の上部ク

 $a = a_m = 2$. $33 \times 10^{-6} (1/K)$ 式 (2) 、 (9) 、 (10) とn=n = 1. 39を式 の共仮周波数の沮度係数m。は式 (11) で教される。※ (5) へ代入することにより温度係数関盤材料搭載部分

ある。そこで第1実施例の設計においては、式 (4) に <) Ludは、(3.0-Lm) mmである。また、半導 やI.Dの超級序数はm₍₁₀=−12.9 (GHz/K) か Dの導数層の等価配折率n こば3.5、石英導波路の等 泪部が母n weiは1. 45 いもろ。1D田幹路旧かのグフ **ーティングの手前までの長さは1.5mmであり、グレ 一アィングの収さは3.0mmである。徐って、半時存** しりぬかのグァーティング中心またの石茶環板路部分の おいて上記のパラメータと式 (3)、式 (8)、式 (1 1) に基づき、モードホップ西度関隔T=140℃とな るように閻度補償材料封入闕城の全長1... を0. 30m また、半導体LDの長さしには0、60mm、半導体L m. = 54 (GH2/K) **及さ(但し、温度係数関整材料が封入された領域を除**

【0042】因1、因2の周故数女定化レーザを上記の パラメータに従って設計し、作製を行った。作製工程を 図3に示す。作製工程は、以下の8工程からなる。

とLSIの作製に用いられるフォトリングラフィ技術を 用いて石英導故略をSi基板上に形成する。13は石英 5。(2)光ファイベの作製技術を応用した火炎堆積法 (1) エッチングにより段差のあるS;基板16を作 導彼路のコア、14は石英導被路のクラッドを示す。

蚊部18 (Siテラス)を作製する。(4) Siテラス る。 (6) 群21をダイシングソーで加工し、幅300 umの構を1本作製する。(7) 半導体レーザ11を位 **酘合わせした後、固定する。(8) 群にシリコーン樹脂** (3) フォトリングラフィおよび反応性イオンエッチン グを用い、石英圏を一部エッチングして半導体レーザ格 ろ。(5) Hキシャワーが光(めるいはアルゴンワーガ の第2萬国故)31をフェイズマスク30を通して導故 路に照射することにより、グレーティング15を作戦す 上に半導体レーザ格鎮用の半田パターン19を形成す を充填し、加黙してシリコーン故脂を硬化させる。

【0043】図4は本安施例1の風波数安定化レーザの 発展周波数の過度依存性の測定結果を扱している。測定 の結果、ホードボップの位置が-15℃から65℃また の範囲で強認できた。また発振のためのしきい値域流は

S ドレーザの上面図を示す。実施例1との相違点は、実施 【0044】 (実施例2) 図5に実施例2の周波数安定 150mATBot.

係数調整材料搭載関核の線膨張係数 a... はSi 基板の線 *Tは後で述べる作製工程の中で説明する。従って、個度 脳張係数となり、式(10)で殺される。 0040]

%[0041]

[数10]

(10)

(11)

例2においては隣と石英導被路がなす角度が82度であ る点である。その他の構成および作製工程は実施例1の 因液数安定化ワーザと回様である。

【0045】溝と石英導被路がなす角度を82度にした

いため、石英導波路と温度係数調整用材料の界面で光の ば、反射光は導破路のコアからクラッドに抜けることで 里由を以下に配做する。 石英導波路との屈折率差が大き な温度係数関整用材料を用いる場合は、屈折率差が大き 反射が大きくなる。大量の反射光が半導体LDに戻った 場合、周波数安定化レーザの発板が不安定になる。従っ て、温度係数調整用材料の種類によっては、温度変化に る。すなむち、周波数安定化ワーザのモードホップの抑 制に石英導波路との屈折率登が大きな温度係数關整用材 対するモードホップの抑制を困避にする場合が生じる。 ところが、|| || と石英導故路がなす角度を82度にすれ LDに戻らず、周波数安定化レーザの発板は安定にな 料も用いることができるようになる。

[0046] 図6は本実施例2の周故数安定化レーザの 発版周故数の閻度依存性の測定結果を救している。モー ドホップの抑制が実施例1と回接に-15度から60度 [0041] (実施例3) 図1および図8に実施例3の 国被数安定化レーザの断固図および上面図を示す。 実施 とである。要するに、300umの構を複数本の狭い構 に分割していることを特徴としている。具体的には、構 をダイシングソーで加工する際に档案加工用のグレード を用い、幅25μmの群を12本作数している。その他 の構成および作製工程は実施例2の周波数安定化レーザ と回様である。 徴定の結果モードホップの哲側が-15 度から65度まで確認され、しきい値電流は、実施例2 例2との相違点は実施例3においては構が複数本あり、 それぞれに温度係数調整用材料 1.2が搭倣されているこ まで確認できた。しきい値観流は150mAであった。 に比較して1桁以上低い10mAが得られた。 జ

[0048]以下、狭い複数個の構を作製して低しきい **直電流が得られた理由を記載する。**

【0049】 導放路中に上部クラッドとコアを除去した 部分または上部クラッドとコアと下部クラッドを除去し た部分、すなわち、構を作製し、導波路構成材料と別の 材料をこの様に搭載すると導波路を透過する光の導波モ ドが安化する。従って様がない場合に比較して透過損

失が生じる。特に、構の導波路方向の全長が長くなるほ ど損失が急速に増加する。従って、一つの太い様に一括 して温度係数開整材料を搭載する場合に比較して、複数 個の細い併に分けて温度保数調整材料を搭載する場合の **方が透過光のロスが少なくなる。よって前者に比較して** 後者の手段を用いた方がレーザキャビティ中の損失を減 少させ、周波数安定化レーザのしきい値電流を減少させ 【0050】 (奥施例4) 図9に奥施例4の周故数安定 て、本実施例4においてはフォトリングラフィーおよび 複数本の溝を連結する溝41を有し、連結用の溝41に 液だめ42が連結されていることを特徴としている。そ のため作製工程における実施例3との相違点は、実施例 連結用の溝と液だめを複数本の溝と同時に一括して作製 化ワーザの上面図を示す。実施図3の構成との違いは、 反応性イオンエッチングによって構加工を行うことで、 3ではダイシングソーで構加工を行っていたのに対し している点である。

点は構の設計の自由度が大きくなる点である。また、反 場合、25μmの構を12本作製するよりも15μmの 【0051】 反応在イメンエッチングによる様だ工の利 でも記載したが、幅の合計の長さが同じ港に温度係数調 て幅の狭い溝を作製できる点である。ダイシングソーを できる溝の最小幅は15μmまで可能である。実施例3 整材料を搭載する場合、より細い構に分割して温度係数 構を20本作製するほうが損失が少ない。 従って、反応 **応性イオンエッチングの利点はダイシングソーに比較し** 反応性イオンエッチングを用いた場合、再現性よく加工 関盤材料を搭載する場合の方が透過損失を低減すること ができる。例えば合計の幅が300μmの潜を作製する ダイシングソーで構加工を行った場合に比較して、周波 性イオンエッチングを用いて隣を作製することにより、 用いた溝加工では22~25μmの幅が限界であるが、 数安定化レーザのレーザキャピティ中の損失を低下さ せ、しきい値電流を低減させる。

て、Siテラス18を作製するためのフォトマスクに1 [0052] 作製工程において、Siテラスの作製と同 時に溝のパターンを作製している。全体の作製工程を図 10に示す。(1)、(2)の工程は図3の工程と同じ である。 (3) のSiテラスおよび構の作製工程におい 5 μ mの構を20本作製する設計および運結用の構と液 に、15μmの溝を20本、連結用の溝および彼だめを 作製している。この方法を用いることによりダイシング ソーで構加工を行った場合に比較して、群加工の工程が 無い分、作戦の効率を上昇させることができる。 (4) だめを作戦する設計を加え、Siテラスの作戦と同時 以降の工程は図3とほぼ同様である。

蛩のシリコーン樹脂を住入することができる。この彼だ で、液だめ42に往入することにより一括して各様に適 【0053】往入したシリコーン樹脂は液体であるの

-OHなど、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオ

က္ထ

めは、構への注入時に液体である材料であればすべての **组度係数関整材料に適用できる。実施例3では、篏だめ** がないので、シリコーン樹脂を充填する際、樹脂が溢れ 出す場合が生じ、注入量の調整が躍しかった。これに比 特尉平11-97784 **枚して奥施例4では、液だめを用いて、一括して適査を** 充填できるので充填の工程の効率化が図れる。 9

度の範囲で確認できた。しきい値電流は8.0mAであ り、実施例3に比較してさらにしきい値電流の低域が陥 [0054] 作製した周波数安定化レーザの発振周波数 の温度依存性を測定した結果、実施例3と同様に実施例 4においてもモードホップの抑制が-15度から+65 **悶された。反応性イオンエッチングを用いて構を細かく** 分割したことによる効果である。

度係数 d n / d T の符号が半導体 L D の屈折率温度係数 "以上のものが好ましい。そのような材料として、低分 子材料、高分子材料、低分子材料を架橋により高分子化 材料は、ほとんどの有機材料の屈折率温度係数の大きさ が条件を満たしており、本発明の周波数安定化レーザに **適用できる。倒えば、ペンゼン、トルエン等の芳香族化** において、温度係数関整材料にはシリコーン樹脂を用い たが、本発明はこれに限定されることはなく、屈折率温 と反対であれば良く、その大きさ (絶対値) は1×10 した材料、高分子と低分子の混合系などがある、低分子 合物、シクロヘキサン毎の暇状炭化木紫化合物、インオ **クタン、ローヘキサン、ローオクタン、ローデカン、ロ** - ヘキサデカン毎の直顧設化水器化合物、四塩化炭器等 の塩化物、2硫化炭繁等の硫化物、メチルエチルケトン 等のケトン類などである。また、高分子材料もほとんど [0055] 実施例1、実施例2、実施例3、実施例4 がdn/dTの絶対値がが1×10-1以上であるため、 ဓ

適用できる。例えば、ポリシロキサンまたはポリシロキ サンの架植物がある。また、倒えば、ポリエチレン、ポ リル酸、ポリアクリル酸メチル、ポリメタクリル酸、ポ リフェニレンオキシド (PPO)、およびその共宜合体 リプロパフン、ポリンチレン等のポリオワフィン、ポリ メタクリル酸ヘキシル、ポリメタクリル酸ドデシル毎の **ピニル重合体、直鎖オレフィン米のポリエーテルや、ポ** S) やポリスルフォン (PSO) 毎のポリエーテル、お 基などの置換基を少なくとも一つ有するもの、例えばH より軽酸アニグ、 おリメチケアニグエーアグ・ポリアク リメタクリル酸メチル、ポリメタクリル酸プチル、ポリ やブレンド体、エーテル茲とスルホン酸基を混在させた ポリエーテルスルホン (PES) 、エーテル苺とカルボ チオエーテル墓を持つポリフェニレンスルフィド(PP よびその共重合体やブレンド体、またはポリオレフィン の末端にOH基、チオール基、カルボニル基、ハロゲン コル基を混在させたポリエーテルケトン基(P E K)、 " (-0-0-0-0) " - (c-0-0-0) -0 ブタジエン、天然ゴム毎のポリジエン、ポリスチレン、 \$

3

係数調盤材料の屈折率および屈折率温度係数の値を用い 数を合わせるため2種以上を混合し、使用する。なお、 て、妖猫剣1に記録した方法で技具を搭載する部分の政 める。 実際にはこれらの材料を単負または屈折母温度保 ポリフッ化アーリアンが挙げられる。 さらには、エポキ 上院の材料を温度保敷調整材料として用いる場合、温度 **ツ苺后ֆの街分中、イリルト参と原穴塔による紫積をが** サシド母のポリメキシドやポリプチバインシアナート、

反射戻り光を低減したが、その角度が80度~87度の **凹いおれば物味は回じいある。** 4において排と導放路のなす角度を82度とすることで 【0056】本発明の英施例2、英施例3および英施例 5

なるようにすれば、攻筋例1、攻筋例2、攻筋例3およ 合計の長さが作製製造も含めて300μm±50μmと ることはなく、掲15~50μmの癖を複数本作取し、 本作製したが、雄の間隔と本数の設計はこれに限定され 2 本作製し、実施例4においては幅15 μ mの滞を20 が300μmの様を存製するために陥25μmの様を1 μmの溝を1本行製し、玻璃図3においては合計の長さ 【0057】 疾徳例 1 および疾徳例 2 においては 300 8

色を記録する。 一ザにも本発明の構成は効果がある。以下に詳しく具体 教权伝介フーチや匠ー塔技士に被教団保護した義成のフ 存の厄波教权伝介フーシバ原伝がちめいかはない。 阿波 の固治数安抗パワーチを認用したが、本光明の必味は母 【0058】 英語例1から英語図4までにおいては単体

汚萄 イギンドッチング でゅう 木合財 ひゃめ。 フーギアフ 構造は、実施例4と同様に、フォトリングラフィーと反 の斑波路を根切る角度を82度としている。 このような 人の出力数は8に限定されるものでなく複数であればよ **刻さは、分割された複数の群が、各周複数安にパフーヂ** 8 匈銭造つたフー サアフィの技式を 土相図 かめる。 いの は有効である。図11は本発明の周被敷安定化レーザを **めいてた行戦したフー护アフムにおいたも本路駅の辞扱** 【0059】(1) 国演教択気元フー耂や複数固様資产

対しても、本発明は有効である。図12は本発明の周波 液だめをそれぞれ2つ取け、分割された複数の流が、各 は1×Nカプラを示す。この例では、近結用の讲および 数安庶化フーザを集積した多波展フーザの模式的上面図 国该教安気のフーギの導致器や模型も角膜を 8 2 乗とし ためる。 20は、アレー格子型 1×N液 長合分波器また ラを供拾した多波県ワーザ(波長え・, え … え 。) に し、アロー格子型1×N液長合分液器または1×Nカフ ング15の各々の反射中心周波数(または液長)を飼卸 **ー卦や丝箍つボフー却ドフム鑵投におごれ、グフードム** 【0060】(2)また、上述の複数の周波数安定化フ ខ

> 数仮に
> カフー
>
> ガと
>
> 被吸
>
> を
>
> に
>
> た
>
> フー
>
> ガ
>
> と
>
> は
>
> 可
>
> 残
>
> な
>
> 用
>
> に
>
> る
>
> い 長が決定されるので、周波数および波長の安定化ないし 制御は同じ意味で用いることができる。要するに、周波 複数であればよい。なお、周波数を決定すると同時に波 協合を例示しているが、これに限定されるものでなく、 たいる。いいた、多波取ワー耂の波取多風数とした8の

構成において、特願平9-47460号に提案されてい とを特徴とする多徴長ワー尹においたも、本発明の構成 **つれ

石財

たなれる

に、

グフー

ル

ム

ソ

グ

ボ

形

長

な

だ

た

で

る** 部分の導液路のコア幅が導液路ごとに異なり、またはグ るような、反射中心徴長が異なるグレーティングを一括 フーティングベクトルがなす角が導液路 ごとに異なるこ フーティングが形成されてこる部分の導液器の光幅とグ 合分液器または1×Nカプラを集積した多液長レーギの 【0061】 (3) また、上記アワー塔子型1×N液吸

N波長合分波器または1×Nカプラを集積した多波長フ 段レーザにおいても、本発明の構成は有効である。 半導体光増幅器が集積されていることを特徴とする多波 **ー 尹の犇成においれ、合被した出力光を福盛するために** ー耂や鉄嶺つたフー护アフノ、またほアフー格斗型1× 【0062】(4)さらに、上記複数の周波数安定化り

フーガにおいたも、本発用の構成は有効にある。 にEA変闘器が集積されていることを特徴とする多波展 において、各波長出力を高速に変調するため半導体LD **ザ、またはさらに半導体光増幅器が集積されている構成** 液果合分液器または1×Nカプラを保積した多液果フー 耂や供指つたフー耂アフム、またはアフー祐斗對1×N 【0063】 (5) また、上記複数の周波数段点化ワー

မ

。 疫闘器が供養されていることを特徴とする多徴展ワー ザにおいても、本発明の構成は有効である。 において、各波長出力を高速に変調するためLiNbO ザ、またはさらに半導体光増幅器が集積されている構成 液吸合分液器または1×Nカプラを集積した多波吸レー ザを供接したフーザアフイ、またはアフー格斗型1×N 【0064】(6)また、上記複数の周複数仮伝代フー

したが、一般的には他の発振波長の半導体LDを用いて **能であることは脅うまでもない。** の全長を適切に設計することでモードホップの抑制が可 する半導体LDを発捩液長1.55μmの半導体LDと も、光緑液路のサイメや、温度保敷調整が料の搭換領域 【0065】実施例1から実施例4では、基板上に搭負

めの牌から半導体LDまでを覆う全領域にこの温度係数 **敷ねる材料である場合、温度係数調整材料を搭載するた** ら実施例4つ述べた温度係数調整材料が樹脂對止材料を 性を確保することが一般的に行われている。 実施例1か LDを拠気にさらさないようにすることで、長期的信頼 るにあたり、LDを樹脂で封止することにより、半導体 【0066】半導体LDを搭載したデバイスを実現化す

関数が料を一括した搭載することにより、モードホッノ

整材料との間で光の反射が生じない。 従って、石英導液 い場合、石英導被路の半導体LD側の始面と温度係数期 対して直交していてもよい。 路の半導体1D囱の幅面はコアの近傍街がコアの光軸に 材料の屈折率が石英導被路の屈折率 n = 1 . 4 5 に等し が必要である。このような構成において、温度係数調整 温度係数調整材料の屈折率に対して設計されていること 載されているので、半導体LDの前端面の反射防止膜は 材料は半導体しDと石英導波路の間の僅かな隙間にも搭 の抑制と半導体しDの信頼性確保が同時に可能になるこ とは含うまでもない。ただし、この場合、温度保数調整

[0067]

用いる分野において多大な効果が期待される。 を用いれば低コストで、温度依存性が小さく安定した単 ドホップを容易に抑制することができる。従って本発明 波長の温度係数を一致させ、従来問題となっていたモー クラッドとコアと下部クラッドを除去した部分に温度係 より、禁ホードの領政保教とグフーディングの反対中心 数調整材料を封入するという簡便な方法を用いることに ―モードレーザの実現が可能となり、光通信等レーザを すなわち上部クラッドとコアを除去した部分または上部 【発明の効果】以上説明したように、本発明では、溝、

|図面の簡単な既明]

135° 【図1】本発明の第1実施例の構造を示す模式的断面図

できる 【図2】本発明の第1実施例の構造を示す模式的上面図

明する模式図である。 【図3】第1実施例の被長安定化レーザの作製工程を説

依存性の測定結果を示す図である。 【図4】本発明の第1実施例における発捩周故数の温度

【図5】本発明の第2実施例の構造を示す模式的上面図

【図6】本発明の第2実施例における発捩周波数の温度

(図 二

8

特関平11-97784

ためる. 依存性の側定結果を示す図である。 【図7】本発明の第3実施例の構造を示す模式的斯面図

できる 【図8】本発明の第3実施例の構造を示す模式的上面図

【図9】本発明の第4 実施例の構造を示す模式的上面図

作製工程を示す模式図である。 【図10】本発用の第4束施例の周旋敷安左化レーギの

フノやボ中様状だ「田図でせる。 【図11】本院用の実施図を供養した存製したフーヂア

一ザを示す模式的上面図である。 【図13】従来のグレーティングを用いた図波敷安広化 【図12】本発明の政施例を集積して作製した多液長っ

フー丼の森状名母院図れるゆ。

フー护において値段数分によるホードホップを観光する 【図14】従来のグレーティングを用いた風波敷安定化

【符号の説明】

道浜京教暨樹芯萃(ツリローソ筆語) 半導体L D

石英導液路のコア層

石英導被路のクラッド層

グレーティング

シリョンテラス Si拼放

1 9 **斗選存フー が 段低の 半田 パターン**

カブラ 20 アレー格子型1×N液長合分液器あるいは1×N

21 漢

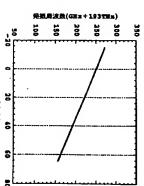
30 フェイズマスク

美國技 31 ドキットフーが光めるいはアグルソフーかの好2

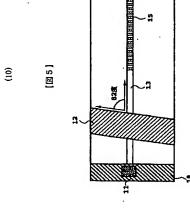
4 1 連結用準

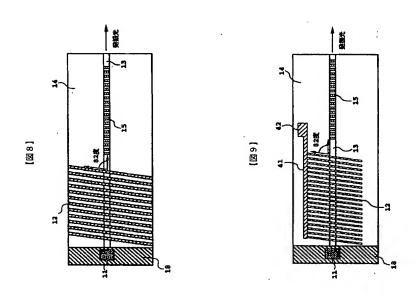
42 液だめ

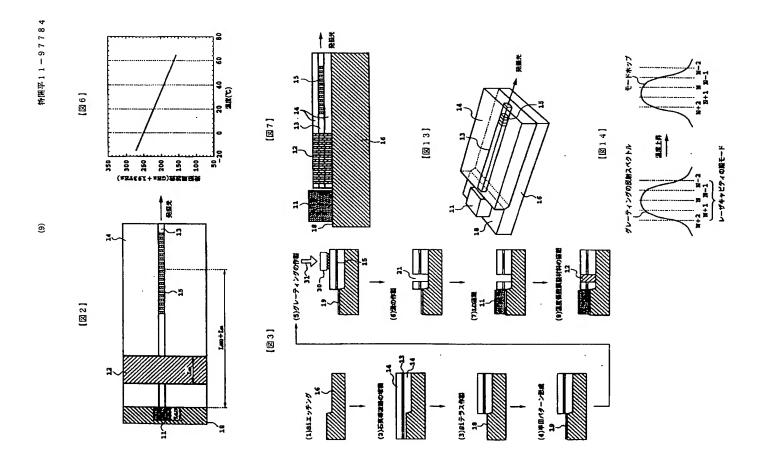
[2 4)



3

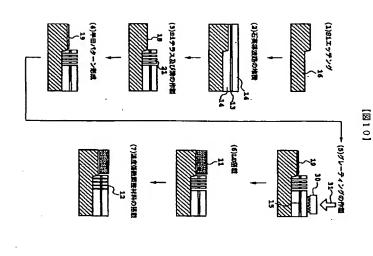


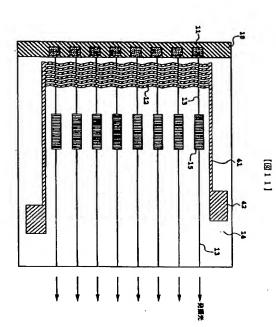




Ξ



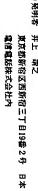


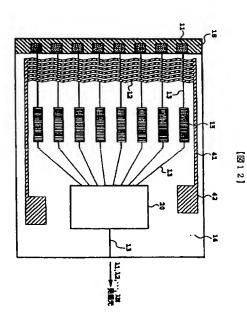


(72) 発明者 姫野 明 レロントページの概念

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本 电信包括株式会社内

(72) 発明者 井上 埼之





(12)

特開平11-97784